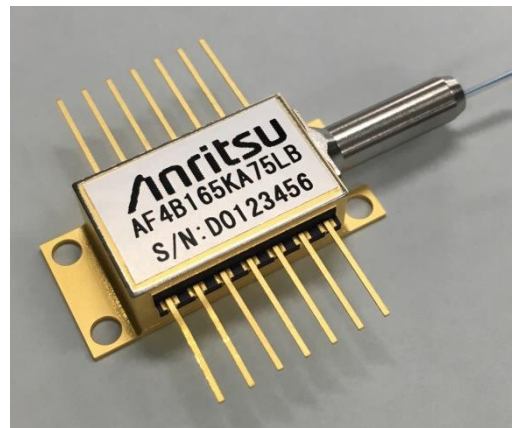


1.48 μ m LD モジュール AF4B シリーズ type E

AF4B SERIES type Eは、Erドープファイバアンプ励起用光源として開発された1.48 μ m帯、高出力・低消費電力LDモジュールです。

特長

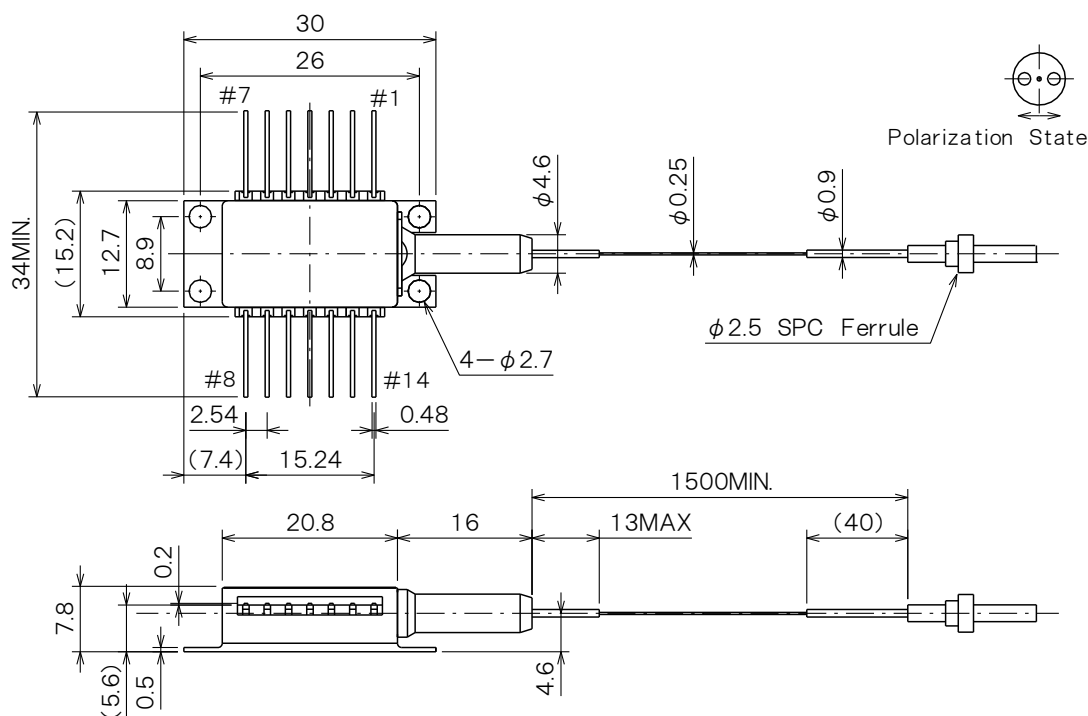
- ・ 光出力 AF4B155KA/KD75LB: 550mW
AF4B160KA/KD75LB: 600mW
AF4B165KA/KD75LB: 650mW
- ・ ファイバタイプ (ϕ 0.25mm UVコート)
シングルモードファイバ (SMF) / 偏波保持ファイバ (PMF)
- ・ 14ピンバタフライパッケージ
- ・ 光アイソレータ、モニタPDおよびクーラ内蔵
- ・ LD動作温度 35 $^{\circ}$ C



用途

- ・ Erドープファイバアンプ励起用

外形寸法 (単位 : mm)



(注) 偏波保持ファイバ仕様LDの偏波方向は、PMFのスロー軸に対して平行です。

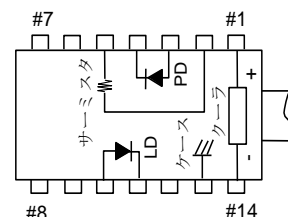
絶対最大定格

端子接続

Top View

項目	記号	定格	単位
LD 順電流	I_F	2800	mA
LD 逆電圧	V_R	2	V
PD 順電流	I_{FD}	10	mA
PD 逆電圧	V_{RD}	20	V
動作ケース温度	T_C	-5 to +70	°C
保存温度	T_{stg}	-40 to +85	°C
クーラ電流	I_C	5.8	A

No.	FUNCTION	No.	FUNCTION
1	クーラアノード	8	NC
2	サーミスタ	9	NC
3	PDアノード	10	LDアノード
4	PDカソード	11	LDカソード
5	サーミスタ	12	NC
6	NC	13	ケース
7	NC	14	クーラカソード



*絶対最大定格を超えると故障の原因になることがあります。

電氣的・光学的特性 ($T_{LD}=35^{\circ}\text{C}$, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

項目	記号	測定条件	Min.	Typ.	Max.	単位
しきい値電流	I_{th}	-	-	-	250	mA
中心波長	λ_c	定格光出力時 RMS (-20dB)	1460	1475	1490	nm
スペクトル幅	$\Delta\lambda$	定格光出力時 -20dB	-	5	10	nm
モニタ電流	I_m	定格光出力時	300	-	3000	μA
PD 暗電流	I_d	$V_{RD}=5\text{V}$	-	-	0.1	μA
トラッキングエラー	ΔP_f	$I_m=\text{const.}, T_C=-5\sim 70^{\circ}\text{C}$	-	-	0.5	dB
アイソレーション	R_O	$T_{LD}=35^{\circ}\text{C}$	-	30	-	dB
*偏波消光比	X_p	定格光出力時	17	-	-	dB
サーミスタ抵抗	R_{th}	$T_{LD}=35^{\circ}\text{C}$	-	6.5	-	k Ω
		$T_{LD}=25^{\circ}\text{C}$	-	10.0	-	

*: PMFのみ

光出力/クーラ特性/消費電力

項目	順電流 (Max.)	順電圧 (Max.)	クーラ電流 (Max.)	クーラ電圧 (Max.)	総消費電力 (Max.)		
記号	I_F	V_F	I_C	V_C	P_{total}		
測定条件	定格光出力時		$I_F=*EOL, T_C=70^{\circ}\text{C}$				
定格 光 出力	550mW	1980	2.00	2.24	2.30	2.85	11.0
	600mW	2170	2.05	2.30	2.60	3.15	13.0
	650mW	2400	2.15	2.41	2.90	3.45	15.5
単位	BOL [mA]	BOL [V]	EOL [V]	EOL [A]	EOL [V]	EOL [W]	

*: $EOL = BOL \times 1.12$

■ オーダーリングインフォメーション

形名 : A F 4 B 1 □ □ K □ □ □ B

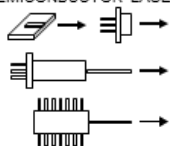
◆ 中心波長精度
L : ±15nm M : ±20nm K : ±

◆ 中心波長
75 : 1475nm 80 : 1480nm
70 : 1470nm 65 : 1465nm

◆ ファイバ種, コネクタ形状
A : SMF フェルル D : PMF フェルル
G : SMF FC/PC K : PMF FC/PC

◆ 光出力
55 : 550mW 60 : 600mW
65 : 650mW

SEMICONDUCTOR LASER



AVOID EXPOSURE

Invisible laser radiation is emitted from this aperture



INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO
DIRECT OR SCATTERED RADIATION



OUTPUT POWER 800mW
WAVELENGTH 0.80 to 1.80 μm
CLASS IV LASER PRODUCT

Caution – use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

This Product Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11

Manufactured Anritsu Corp. 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, Japan

Anritsu envision : ensure

お見積り、ご注文、修理などは、下記までお問い合わせください。
記載事項は、おことわりなしに変更することがあります。

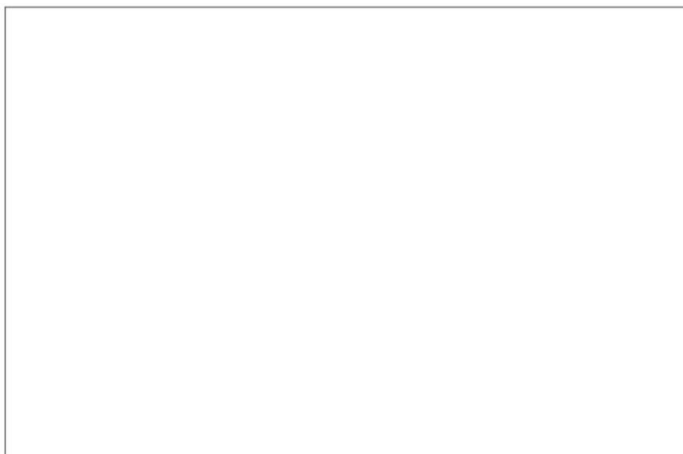
アンリツ株式会社

アンリツ株式会社 デバイス営業部
アンリツデバイス株式会社 マーケティング部

〒243-0016 神奈川県厚木市田村町8-5
TEL 046-296-1228 FAX 046-296-1254

URL: <http://www.anritsu.com/anritsu-devices>

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

■カタログの記載内容は2018年6月12日現在のものです。